★シリコン材料・デバイス研究会（SDM）

専門委員長　大野裕三　副委員長　国清辰也
幹事　黒田理人　幹事補佐　山口　直

日時　10 月 29 日（木）　14：00～17：20
　　30 日（金）　9：30～16：00

会場　東北大学未来科学技術共同研究センター未来情報産業研究館 5F（仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10. http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/contactus.html　TEL〔022〕795-4833　黒田理人）

議題　プロセス科学と新プロセス技術

29 日

1.〔招待講演〕 イオン注入技術の現状と課題　○中島良樹・濱本成顕・酒井滋樹・鈇田　博（日新イオン機器）
2. Ar/H_2 混合ガス熱処理による Si 表面平坦化プロセスの検討　○工藤聡也・大見俊一郎（東工大）
3. Xe/H_2 プラズマを用いたシリコン基板表面の低温平坦化技術
　○諏訪智之・寺本章伸・後藤哲也・平山昌樹・須川成利・大見忠弘（東北大）
4. Electrical Properties of MOSFETs Introducing Atomically Flat Gate Insulator/Silicon Interface
　○Tetsuya Goto・Rihito Kuroda・Tomoyuki Suwa・Akinobu Teramoto・Toshiki Obara・Daiki Kimoto・Shigetoshi Sugawa（Tohoku Univ.）・Yutaka Kamata・Yuki Kumagai・Katsuhiko Shibusawa（LAPIS Semi. Miyagi）
5.〔招待講演〕 フラッシュメモリと CMOS ロジックの近接混載技術による低消費電力・高速 FPGA
　○財津光一郎・辰村光介・松本麻里・小田聖翔・安田心一（東芝）

30 日午前

1.〔招待講演〕 マイクロ波励起プラズマによる立体構造体への等方均一注入技術
　○上田博一（TEL TDC）・ピーター ベントゼック（TEL AMERICA）・岡　正浩・小林勇気・杉本靖広・川上聡（TEL TDC）
2. トンネル電流・拡散電流併用 MOSFET のデバイスシミュレーション検討
　○古川貴一・黒田理人（東北大）・小尻尚志（日本ゼオン）・諏訪智之・橋本圭市・寺本章伸・須川成利（東北大）
3. 酸素ラジカル処理を用いた強誘電体 $BiFeO_3$ 薄膜の形成技術
　○今泉文伸・後藤哲也・寺本章伸・須川成利（東北大）

30 日午後

4.〔招待講演〕 大画面シート型ディスプレイ実現に向けたディスプレイ材料・プロセス技術　藤崎好英（NHK）
5. HfO_2 をゲート絶縁膜に用いたペンタセン OFET のデバイス特性に関する検討
　○前田康貴・劉　野原・大見俊一郎（東工大）
6. 窒素添加 LaB_6 ターゲットによる低仕事関数 LaB_6 スパッタ薄膜の形成
　○石井秀和（東北大）・高橋健太郎（住友大阪セメント）・後藤哲也・須川成利・大見忠弘（東北大）
7. Investigation of stacked HfN gate insulator formed by ECR plasma sputtering
　○Nithi Atthi・Shun-ichiro Ohmi（Tokyo Inst. of Tech.）
8. 高精度ガス制御器を用いた A1203 の ALD 成膜におけるプロセス温度の検討
　○杉田久哉・幸田安真・諏訪智之・黒田理人・後藤哲也・石井秀和（東北大）・山下　哲（フジキン）・寺本章伸・須川成利・大見忠弘（東北大）

◎29 日 17：20～平成 26 年度シリコン材料・デバイス研究専門委員会若手優秀発表賞表彰式，17：50～19：30 に懇親会を開催します.

☆SDM 研究会今後の予定　〔　〕内発表申込締切日
　11 月 5 日（木），6 日（金）　機械振興会館〔締切済〕テーマ：プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般
　12 月 14 日（月）　龍谷大響都ホール校友会館〔10 月 9 日（金）〕テーマ：シリコン関連材料の作製と評価及びディスプレイ技術

【発表申込先】　下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.
　http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html

【問合先】
黒田理人（東北大）
TEL〔022〕795-4833，FAX〔022〕795-4835
E-mail：rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp